

HY17P60B Series

BIE应用注意事项

TOPIC

前言

产品型号

注意事项

建议方案

前言

- ◆ 针对HY17P60B产品在使用BIE功能时的注意事项说明，并提出建议方式。

产品型号

- ◆ 此应用注意事项适用以下产品型号
 - HY17P60B 系列产品
型号：HY17P60B-D000
HY17P60B-L064
HY17P60B-NS32

注意事项

◆ 硬件部份

- 使用8.5V外灌VPP电压进行BIE烧录时，周边电路可能会造成电压下降，导致BIE烧录失败，故建议使用8.6V~8.7V操作。
- 烧录过程必须确保COM0保持低电位，以下提供两种方式：
 - 将COM0外接一个下拉电阻到VSS，建议为0Ω~1MΩ，该电阻值以不影响LCD显示为主。
 - 将另一个没有使用的引脚与COM0短路，进入BIE函式前，关闭LCD显示再把该引脚设置成输出低电位；离开BIE函式后，关闭该引脚输出模式再开启LCD显示，避免LCD显示异常。

注意事项

◆ 软件部份

- 不论采用内部升压或外灌VPP电压方式进行BIE烧录时，一定要使用HYCON所提供的『HY17P60BWR3.lib』或『17P60BWR3.obj』里的函式进行BIE烧录。
- 当烧录完成后需 Delay 300mS，用户再重新设定LCD相关暂存器，才可以在正常模式使用。(外灌VPP电压方式需移除外灌电压才算烧录完成，再进行Delay300mS)
- 操作BIE读写前必须关闭GIE中断

建议方法-1

◆ BIE操作时必须使用HYCON所提供的BIE烧烧函式库：

- Demo Code包含4个档案



- 内部升压可参考范例程序BIE_LVD_ASM或BIE_LVD_C
- 外灌VPP可参考范例程序BIE_EXTVPP_ASM或BIE_EXTVPP_C

建议方法-2

- ◆ 采用内部升压方式进行BIE烧录时，一定要使用HYCON所提供的『LV17P60BWR3』函式进行BIE烧录。范例：

C Language	ASM Language
Address=0000,Data=0xAA11	Address=0000,Data=0xAA11
result=LV17P60BWR3(0,0,0xAA,0x11);	CLRF BIEARH CLRF BIEARL MVL 0AAH MVF BIEDRH,F,A MVL 11H MVF BIEDRL,F,A call LV17P60BWR3BIE nopf LV17P60BWR3BIE BTSZ WREG,0,A
Return 0= pass, 1= VDD<2.75V, 2= VPP<8.5V	WREG= 0 pass, =1 fail

建议方法-2

- ◆ 采用外灌VPP方式进行BIE烧录时，一定要使用HYCON所提供的『EXT17P60BWR3』函式进行BIE烧录。范例：

C Language	ASM Language
Address=1C00,Data=0xAA11	Address=1C00,Data=0xAA11
result=EXT17P60BWR3(0x1C,0,0xAA,0x11);	MVL 0x1C MVF BIEARH,F,A CLRF BIEARL MVL 0AAH MVF BIEDRH,F,A MVL 11H MVF BIEDRL,F,A call EXT17P60BWR3BIE nopf EXT17P60BWR3BIE BTSZ WREG,0,A
Return 0= pass, 1= VDD<2.75V, 2= VPP<8.5V	WREG= 0 pass, =1 fail

Thank you

Sales@hycontek.com